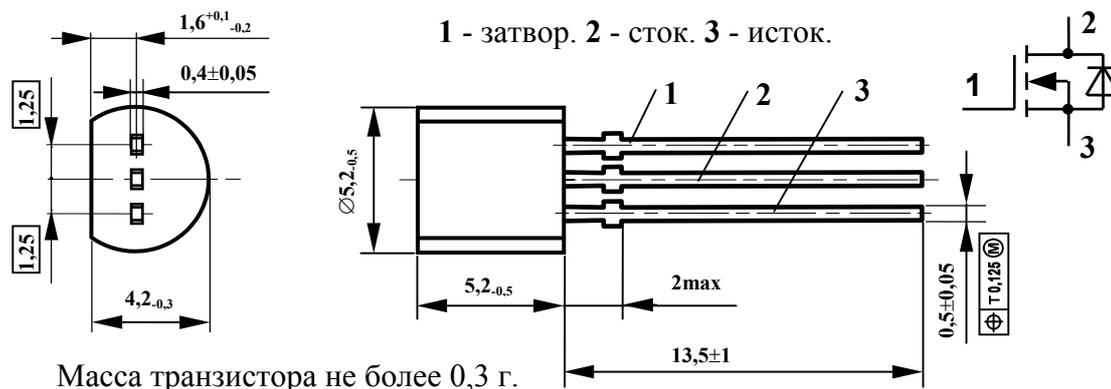


АДБК 432140.690 ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изолированным затвором и N-каналом транзисторы КП504А, КП504Б, КП504В, КП504Г в пластмассовом корпусе КТ 26. Предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах с непрерывным импульсным управлением, блоках питания ЭВМ, в схемах управления электродвигателями и другой радиоэлектронной аппаратуре.



Предельно допустимые режимы эксплуатации.

Параметры	Обозначение	Ед. изм	Значение
Постоянное напряжение сток-исток КП504А, Б КП504В КП504Г	Uси max	В	240
			200
			250
Постоянное напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±10
Постоянный ток стока	Iс max	А	0.25
Импульсный ток стока	Iс и max	А	1.0
Постоянная рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	1.0
Температура перехода	Tпер	°С	150

Основные электрические параметры (Токр. ср. == 25°С).

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Iс=1.0мА, Uзи=Uси	0.6	1.2
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП504А-В КП504Г	Rси отк	Ом	tи≤300мкс. Q ≥50 Iс=250мА, Uзи=4.5В Iс=14мА, Uзи=1.8В		8 15
			Iс=250мА, Uзи=4.5В Iс=14мА, Uзи=1.8В		10 18
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Uси=240В, Uзи=0		1.0
Ток утечки затвора	Iз ут	нА	Uси=0, Uзи= ±20В ти≤300мкс. Q ≥50		± 100
Крутизна ВАХ	S	А/В	ти≤300мкс. Q ≥50 Uси ≥4В, Iс=250мА	0.14	
Прямое напряжение на диоде КП504А,В,Г КП504Б	*Uпр	В	ти≤300мкс. Q >50		
			Uзи=0, Iс= -500мА		1.3 1.8
Время включения	* твкл	нс	Uзи=10В, Iс= 280мА Uси=30В, Rзи=50 Ом ти≤300мкс. Q >50		32
Время выключения	* твыкл	нс	Uзи=10В, Iс= 280мА Uси=30В, Rзи=50 Ом ти≤300мкс. Q >50		70
Входная емкость	* C11и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		140
Выходная емкость	* C22и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		30
Проходная емкость	* C12и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		9

* справочные параметры.